

Modulbezeichnung: Crystal Growth & Semiconductor Technology MWT (M2 - 12.5 ECTS M3) (CGMWT)
(Crystal growth MWT)

Modulverantwortliche/r: Peter Wellmann

Lehrende: Jochen Friedrich, Peter Wellmann

| | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Startsemester: WS 2015/2016 | Dauer: 2 Semester | Turnus: halbjährlich (WS+SS) |
| Präsenzzeit: 120 Std. | Eigenstudium: 255 Std. | Sprache: Deutsch und Englisch |

Lehrveranstaltungen:

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie (WS 2015/2016, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

Praktikum Wahlfach Crystal Growth (WS 2015/2016, Praktikum, 3 SWS, Peter Wellmann)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen (Technologie II) (SS 2016, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

Exkursionen (SS 2016, Exkursion, Peter Wellmann)

Wahlvorlesungen

Aus den optionalen Wahlveranstaltungen können Vorlesungen gewählt werden, die mit 3 ECTS in das Modul eingehen.

Halbleiter großer Bandlücke (SS 2016, optional, Vorlesung, 1 SWS, Peter Wellmann)

Technologie der Züchtung von Halbleiterkristallen und Photovoltaik (SS 2016, optional, Vorlesung, 1 SWS, Jochen Friedrich)

Aufbau- und Verbindungstechnik in der Leistungselektronik (WS 2015/2016, optional, Vorlesung, 2 SWS, Uwe Scheuermann)

Numerische Modellierung des Kristallwachstums mithilfe des Programmpakets COMSOL Multi-Physics (SS 2016, optional, Vorlesung mit Übung, 1 SWS, Anwesenheitspflicht, Peter Wellmann)

Empfohlene Voraussetzungen:

Bachelor in Materialwissenschaft, Nanotechnologie, Energietechnik, Elektrotechnik, Physik, Chemie oder in einem vergleichbaren Studiengang.

Inhalt:

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie

- Grundlagen des Kristallwachstums
- Grundlagen der Silizium Halbleitertechnologie (Oxidation, Dotierung mittels Diffusion und Ionenimplantation, Ätzen, Metallisierung Lithographie, Packaging)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen

- Korrelation von Bauelementfunktion (Bipolar-Diode, Bipolar-Transistor, Schottky-Diode, Feldeffekt-Transistor, Leucht- und Laserdiode) mit Materialeigenschaften
- Grundlagen der Epitaxie

Praktikum:

- Czochralski Kristallwachstum von InSb
- Modellierung in der Kristallzüchtung
- Halbleitercharakterisierung

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden

- erwerben fundierte Kenntnisse über Materialeigenschaften und deren Anwendungen in elektronischen Bauelementen
- lernen experimentelle Techniken in den Werkstoffwissenschaften kennen und können sie selbständig anwenden
- können Theorien, Terminologien und Lehrmeinungen des Faches, erläutern, anwenden und reflektieren
- können in Gruppen kooperativ und verantwortlich arbeiten

Literatur:

wird in den Lehrveranstaltungen angegeben

Studien-/Prüfungsleistungen:

Crystal Growth MWT 3 (Prüfungsnummer: 63701)

(englische Bezeichnung: Crystal growth MWT)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 20

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

Erstablingung: WS 2015/2016, 1. Wdh.: SS 2016

1. Prüfer: Peter Wellmann
